

LAPT 2SC3519/3519A

シリコンNPNエピタシャルプレーナ型トランジスタ (2SA1386/1386Aとコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

絶対最大定格 (Ta = 25)

電気的特性 (Ta = 25)

記号	規格値		単位
	2SC3519	2SC3519A	
V _{CB0}	160	180	V
V _{CE0}	160	180	V
V _{EBO}	5		V
I _C	15		A
I _B	4		A
P _C	130(T _C = 25)		W
T _J	150		
T _{stg}	- 55 ~ + 150		

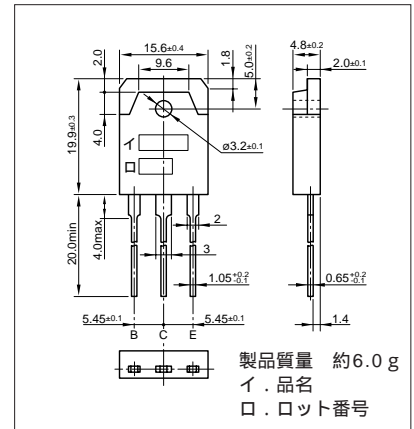
記号	試験条件	規格値		単位
		2SC3519	2SC3519A	
I _{CB0}	V _{CB} =	160	180	μA
I _{EBO}	V _{EB} = 5V	100max		μA
V _{(BR)CEO}	I _C = 25mA	160min	180min	V
h _{FE}	V _{CE} = 4V, I _C = 5A	50min		
V _{CE(sat)}	I _C = 5A, I _B = 0.5A	2.0max		V
f _T	V _{CE} = 12V, I _E = - 2A	50typ		MHz
C _{OB}	V _{CB} = 10V, f = 1MHz	250typ		pF

ランク \bar{O} (50~100), P(70~140), Y(90~180)

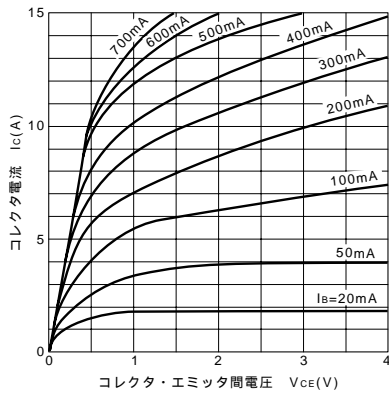
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (A)	I _{B2} (A)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
40	4	10	10	-5	1	-1	0.2typ	1.3typ	0.45typ

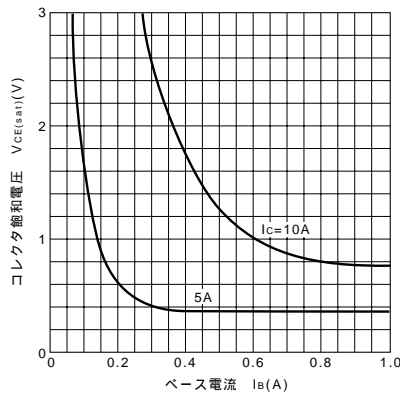
外形図 MT-100(TO3P)



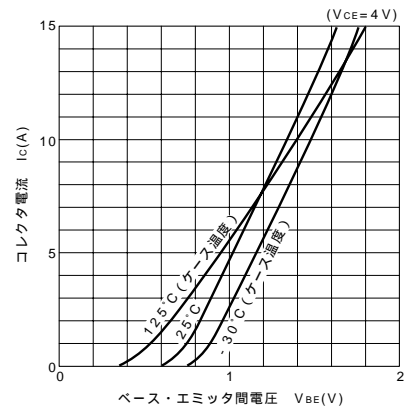
I_C-V_{CE}特性 (代表例)



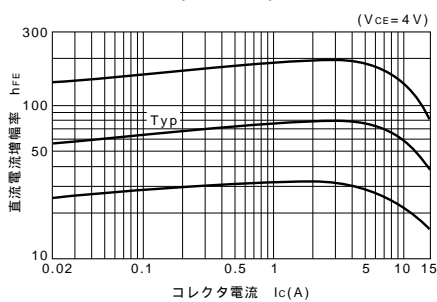
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



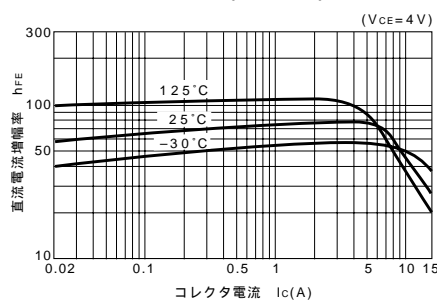
I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)



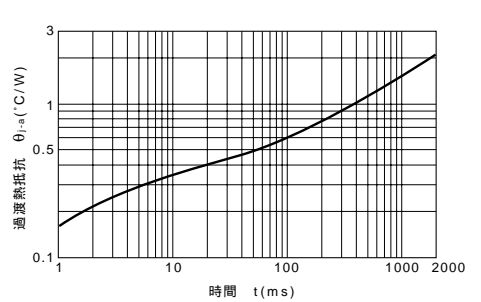
h_{FE}-I_C特性 (代表例)



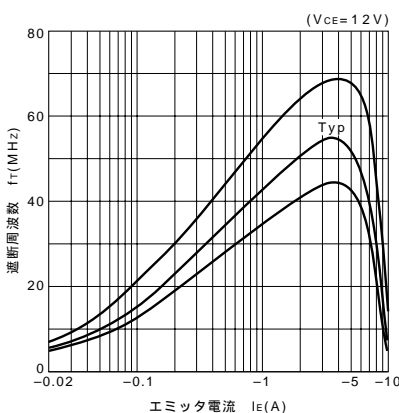
h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)



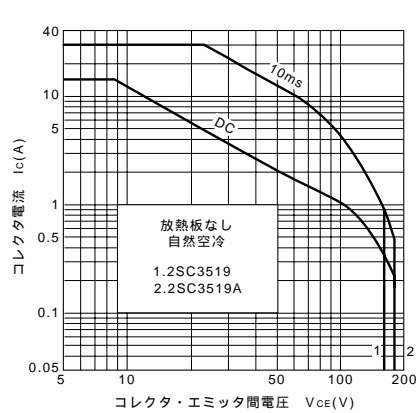
θ_{j-a}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_C-T_a定格

